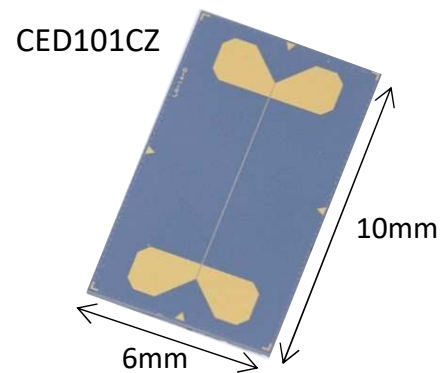
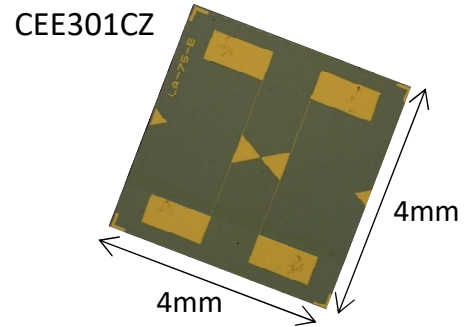


当社の InGaAs PCA エミッタと LT-GaAs PCA ディテクタは、高ダイナミックレンジと広帯域 THz-TDS 測定を実現するために精密に設計され、1.55 μm 通信波長帯フェムト秒レーザーでの使用に最適化されています。どちらも自由空間系 PCA モジュールおよびエピウエハー基板でのご提供も可能です。これらの多用途コンポーネントは、最先端のテラヘルツシステムに統合できます。

構成

| Model | CEE301CZ | CED101CZ |
|--------|-------------------|-------------------|
| タイプ | Emitter | Detector |
| チップサイズ | 4mm x 4mm | 6mm x 10mm |
| チップ厚 | 350 μm | 350 μm |
| アンテナ | ボウタイ | ダイポール |
| ギャップ | 30 μm | 3.4 μm |
| 基板 | InP | SI-GaAs |
| 光伝導層 | Fe-doped InGaAs | LT-GaAs |
| 励起波長 | 1560nm | 780nm/1560nm |



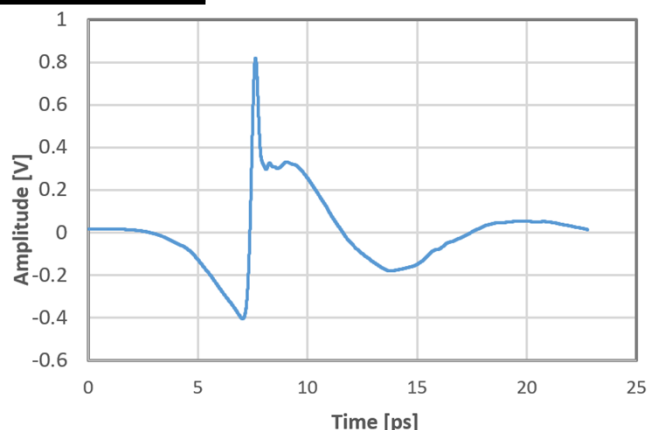
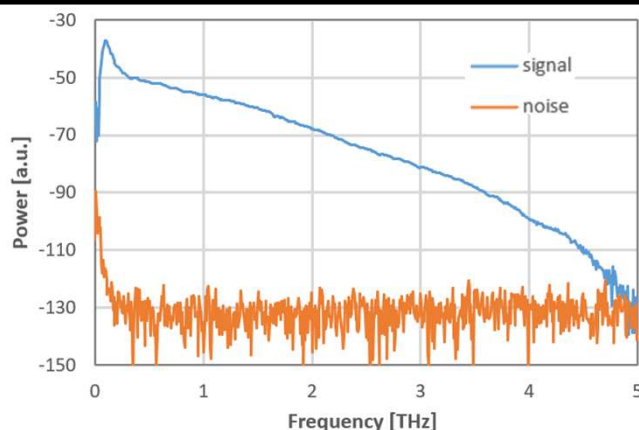
最大定格

| Model | CEE301CZ | CED101CZ |
|-----------------|--|--|
| 印可電圧 | $\pm 20\text{V}$ | - |
| 励起光平均パワー ※1, ※2 | 20mW ※3 | 20mW |
| 動作温度 ※4 | 0 $^{\circ}\text{C}$ to +40 $^{\circ}\text{C}$ | 0 $^{\circ}\text{C}$ to +40 $^{\circ}\text{C}$ |
| 保存温度 ※4 | -20 $^{\circ}\text{C}$ to +60 $^{\circ}\text{C}$ | -20 $^{\circ}\text{C}$ to +60 $^{\circ}\text{C}$ |

- ※1 繰り返し周波数 50MHz ~ 150 MHz
- ※2 パルス幅 30fs 以上
- ※3 チップ表面におけるスポット径 100 μm (1/e²) 以上
- ※4 結露無きこと

特性

| Parameter | CEE301CZ | CED101CZ |
|-----------|--------------|--------------|
| 暗抵抗(最小値) | 50k Ω | 20M Ω |



注意 :この文書は予告なしに変更されることがあります。ご検討の際は、最新の資料をご確認ください。

April. 16, 2025 PI1898-1J

開発・製造

YITOAマイクロテクノロジー株式会社
〒400-0053 山梨県甲府市大里町465
TEL: 055-241-8611
<https://www.micro-technology.co.jp>

販売

株式会社アイスペック・インスツルメンツ
〒910-0067 福井県福井市新田塚一丁目80番15号
TEL: 0776-76-2050
Email: aii-information@mbr.nifty.com